R1200/R1200F – R5000/R5000F

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ДИОД

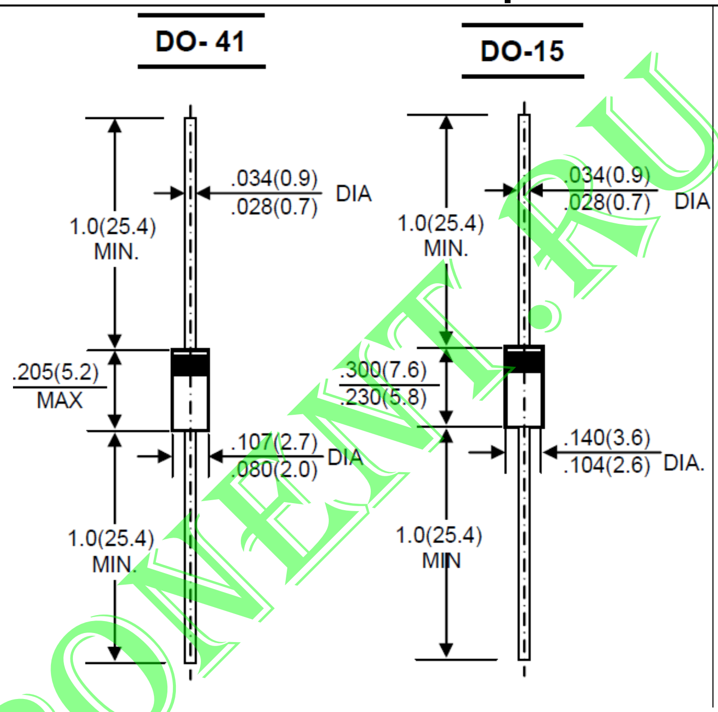
диапазон напряжения от 1200 до 5000 вольт ток 0.2/0.5 ампера

ОСОБЕННОСТИ:

- Высокое напряжение
- Высокий ток
- Низкий ток утечки
- Высокая перегрузочная способность
- Низкая стоимость

Механические данные

- Корпус: литой пластиковый корпус DO-41\DO-15
- Пластиковые материалы UL классификация воспламеняемости 94 V-0
- Вывода: аксиальные вывода, пайка в MIL-STD-202, методика 208
- Полярность: цветовое кольцо обозначает катод
- Монтажное положение: любое
- Вес: 0.35 грамма



Размеры в дюймах и (мм)

МАКСИМАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

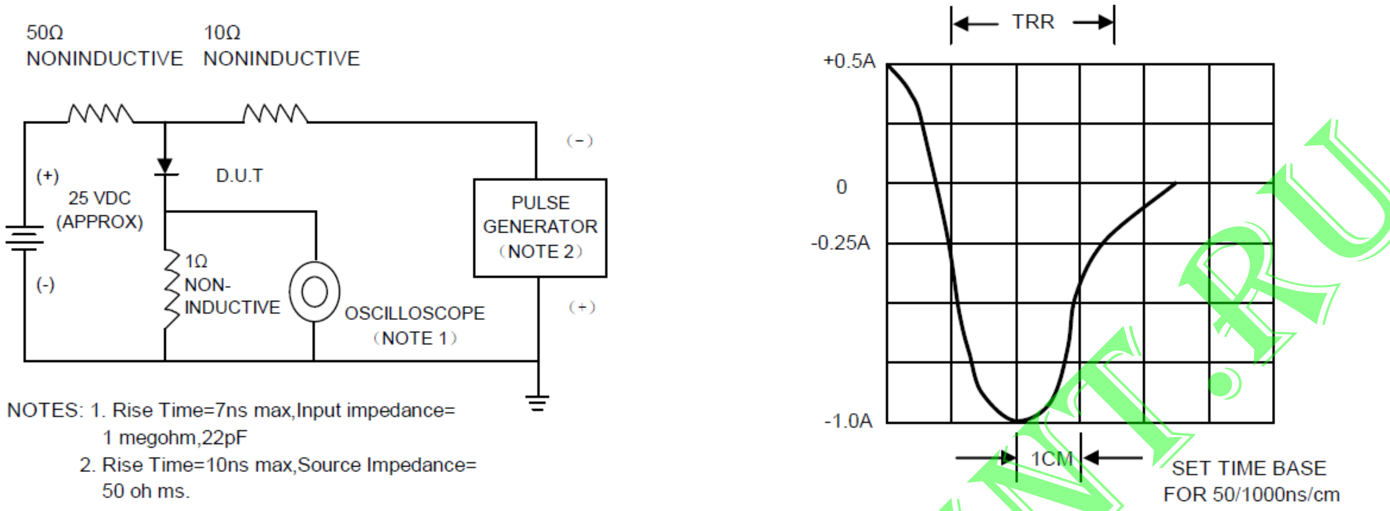
Значения параметров при 25°C температуре окружающей среды, если не указано иное.
Однофазный, напряжение (В) половина волны, частота – 50 Гц, для резистивных и индуктивных нагрузок.
Для емкостной нагрузки уменьшайте ток на 20%

ТИП		R1200 R1200F	R1500 R1500F	R1800 R1800F	R2000 R2000F	R2500 R2500F	R3000 R3000F	*R4000 *R4000 F	*R5000 *R5000 F	Единица измерения
Максимальное пиковое обратное напряжение	V_{RRM}	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	**В**
Максимальный средний прямой выпрямленный ток резистивная нагрузка 60 Гц T_A = 50°C	$I_{F(AV)}$	500				200				мА
Максимальный прямой ток импульса в течении 8.3 мсек. (JEDEC метод)	I_{FSM}	30								А
Максимальный постоянный обратный ток при номинальном постоянном обратном напряжении T_J = 25°C T_J = 100°C	I_R	5.0 50								мкА
Максимальное падение напряжения на открытом диоде при прямом токе 0.5/0.2 А	V_F	2 3				4.5 5				В
Типичное время обратного восстановления (Примечание 1)	T_{RR}	- 500				- 500				нсек.
Типичная емкость перехода, на выводах	C_J	30								пФ
Диапазон рабочих температур	T_J	-65 до +150								"С
Диапазон температур хранения	T_{STG}	-65 до +150								**°С**

Примечание: 1. Обратное восстановление, условия тестирования: I_F **= 0.5A,** I_R **= 1,0A,** I_{RR}**= 0.25A.**
2. * Только корпус DO-15.

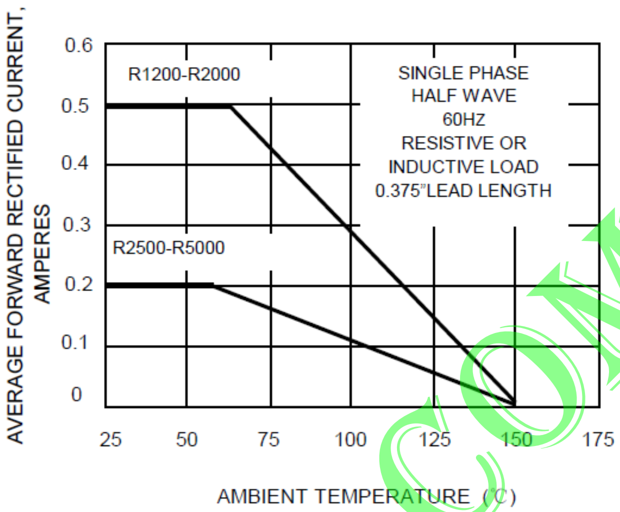
ГРАФИКИ ХАРАКТЕРИСТИК
R1200/R1200F – R5000/R5000F

FIG.1-REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC AND TEST CIRCUIT DIAGRAM



NOTES: 1. Rise Time=7ns max,Input impedance=
1 megohm,22pF
2. Rise Time=10ns max,Source Impedance=
50 oh ms.

FIG. 2 – FORWARD CURRENT DERATING CURVE



FLG.3 –TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS

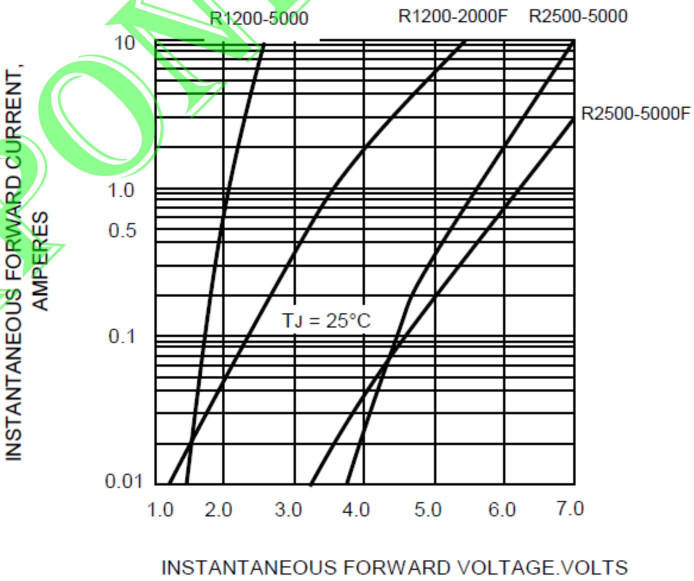


FIG.4-PEAK FORWARD SURGE CURRENT